

Sukcesywne dostawy podłoży szafirowych				
l.p.	nazwa przedmiotu zamówienia	opis	ilość sztuk w pojedynczym opakowaniu	przewidywana ilość opakowań
1	Podłoża szafirowe do wzrostu MOVPE, offcut 0.3°, SSP	2 calowe podłoża Al2O3 jednostronnie polerwane, gdzie płaszczyzna C jest odchylona o 0.3° względem osi M, wyhodowane metodą Kyropoulusa, czystość materiału: 99,999%, monokryształ, klasa krystaliczna: klasa optyczna 1, klasa procesowa: epi-ready, orientacja powierzchni: płaszczyzna C (0001) pod kątem 0.3 +/- 0.1° względem osi M, średnica 50.8 mm +/- 0.1 mm, grubość 430 μm +/- 25 μm, orientacja głównego ścięcia: płaszczyzna A (11-20) +/- 0,2°, długość głównego ścięcia: 16.0 mm +/- 1.0 mm, górna powierzchnia epi-polished, Ra < 0.2 nm (według AFM), tylna powierzchnia fine ground, Ra = 0.8 μm -1.2 μm, pakowane próżniowo w clean roomie o klasie 100 w pudełka po 25 sztuk.	25 szt/opakowanie	4
2	Podłoża szafirowe do wzrostu MOVPE, offcut 0.6°, SSP	2 calowe podłoża Al2O3 jednostronnie polerwane, gdzie płaszczyzna C jest odchylona o 0.6° względem osi M, wyhodowane metodą Kyropoulusa, czystość materiału: 99,999%, monokryształ, klasa krystaliczna: klasa optyczna 1, klasa procesowa: epi-ready, orientacja powierzchni: płaszczyzna C (0001) pod kątem 0.6 +/- 0.1° względem osi M, średnica 50.8 mm +/- 0.1 mm, grubość 430 μm +/- 25 μm, orientacja głównego ścięcia: płaszczyzna A (11-20) +/- 0,2°, długość głównego ścięcia: 16.0 mm +/- 1.0 mm, górna powierzchnia epi-polished, Ra < 0.2 nm (według AFM), tylna powierzchnia fine ground, Ra = 0.8 μm -1.2 μm, pakowane próżniowo w clean roomie o klasie 100 w pudełka po 25 sztuk.	25 szt/opakowanie	8
3	Podłoża szafirowe do wzrostu MOVPE, offcut 0.8°, SSP	2 calowe podłoża Al2O3 jednostronnie polerwane, gdzie płaszczyzna C jest odchylona o 0.8° względem osi M, wyhodowane metodą Kyropoulusa, czystość materiału: 99,999%, monokryształ, klasa krystaliczna: klasa optyczna 1, klasa procesowa: epi-ready, orientacja powierzchni: płaszczyzna C (0001) pod kątem 0.8 +/- 0.1° względem osi M, średnica 50.8 mm +/- 0.1 mm, grubość 430 μm +/- 25 μm, orientacja głównego ścięcia: płaszczyzna A (11-20) +/- 0,2°, długość głównego ścięcia: 16.0 mm +/- 1.0 mm, górna powierzchnia epi-polished, Ra < 0.2 nm (według AFM), tylna powierzchnia fine ground, Ra = 0.8 μm -1.2 μm, pakowane próżniowo w clean roomie o klasie 100 w pudełka po 25 sztuk.	25 szt/opakowanie	8
4	Podłoża szafirowe do wzrostu MOVPE, offcut 1°, SSP	2 calowe podłoża Al2O3 jednostronnie polerwane, gdzie płaszczyzna C jest odchylona o 1° względem osi M, wyhodowane metodą Kyropoulusa, czystość materiału: 99,999%, monokryształ, klasa krystaliczna: klasa optyczna 1, klasa procesowa: epi-ready, orientacja powierzchni: płaszczyzna C (0001) pod kątem 1° +/- 0.1° względem osi M, średnica 50.8 mm +/- 0.1 mm, grubość 430 μm +/- 25 μm, orientacja głównego ścięcia: płaszczyzna A (11-20) +/- 0,2°, długość głównego ścięcia: 16.0 mm +/- 1.0 mm, górna powierzchnia epi-polished, Ra < 0.2 nm (według AFM), tylna powierzchnia fine ground, Ra = 0.8 μm -1.2 μm, pakowane próżniowo w clean roomie o klasie 100 w pudełka po 25 sztuk.	25 szt/opakowanie	12
5	Podłoża szafirowe do wzrostu MOVPE, offcut 1° DSP	2 calowe podłoża Al2O3 jednostronnie polerwane, gdzie płaszczyzna C jest odchylona o 1° względem osi M, wyhodowane metodą Kyropoulusa, czystość materiału: 99,999%, monokryształ, klasa krystaliczna: klasa optyczna 1, klasa procesowa: epi-ready, orientacja powierzchni: płaszczyzna C (0001) pod kątem 1 +/- 0.1° względem osi M, średnica 50.8 mm +/- 0.1 mm, grubość 430 μm +/- 25 μm, orientacja głównego ścięcia: płaszczyzna A (11-20) +/- 0,2°, długość głównego ścięcia: 16.0 mm +/- 1.0 mm, górna powierzchnia epi-polished, Ra < 0.2 nm (według AFM), tylna powierzchnia Epi-polished, Ra < 0.2 nm (by AFM), pakowane próżniowo w clean roomie o klasie 100 w pudełka po 25 sztuk.	25 szt/opakowanie	4